

H29 年度第 4 回固体物理セミナー報告書

日 時： 2017 年 11 月 16 日(木) 14:40 ~16:10

場 所： 基礎工学研究科 講義棟 A403

講師名： 富嶋 茂樹

講師所属： Intel Corporation, Intel Labs

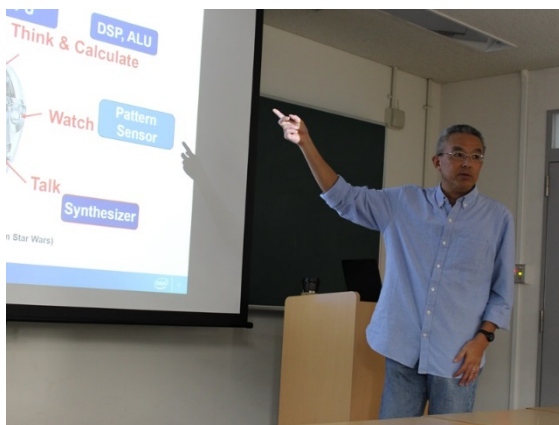
講演タイトル：「エレクトロニクス分野におけるメモリ・デバイスの物理と種類」

概 要： 昨今のエレクトロニクスの発展には、CPUの進歩と同時にメモリデバイスの進化が必須です。何故ならば、CPUが演算処理をするのに、演算する前の、または、した後のデータを記憶しておく場所が必要だからです。

主に、プロセス技術の微細化、トランジスタの特性向上によって、性能アップしてきたCPUと比べると、メモリ・デバイスは、データの記憶メカニズム、材料からして、色々な種類と住み分けがあります。

このセミナーでは、エレクトロニクス分野のメモリ階層構造の紹介から、各階層に位置しているメモリ・デバイスの紹介、そして、最近提案されている新規メモリ・デバイスと、半導体業界での最新メモリ情報をご紹介します。

講義の様子



主催した先生の感想

今回は物性や物理というよりもエレクトロニクスの応用さらにはマーケットの話であったが、みな興味があるようで熱心に聴講していた。このようないつもは聞けない話をしていただくのも有意義であると感じた。

基礎工学研究科 教授 鈴木義茂